ДЕТЕКТОР ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микросхема К1230ДП46хх (К1230ДП87хх) представляет собой детектор понижения напряжения ниже допустимого уровня. Микросхема предназначена для использования в микропроцессорных системах с 5-ти (9-ти) вольтовым питанием для формирования сигнала Reset во всех случаях, когда напряжение питания снижается до опасного, с точки зрения безошибочной работы системы, уровня.

Для применений, где необходимо управлять нагрузкой, имеющей больший потенциал, чем входное напряжение, может оказаться полезной модификация микросхемы без защитного диода (К1230ДП461х, К1230ДП871х). Выход модифицированной микросхемы с открытым коллектором в закрытом состоянии допускает подачу на него напряжения до 20 В с утечкой не более 1 мкА.

Аналогом микросхемы K1230ДП46xx является микросхема MC33064 фирмы "MOTOROLA".

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Запоминающие устройства (ОЗУ) с аварийным батарейным питанием;
- Средства защиты от неправильного функционирования микропроцессорной системы при включениях/выключениях питания;
- Средства защиты от неправильного функционирования микропроцессорной системы в результате случайных перебоев подачи питания;
- Как компонент средств установки в исходное состояние микропроцессорного оборудования: персональных компьютеров, принтеров, видеомагнитофонов, автомобильных контролеров и др.
- Зарядные устройства

Корпус ТО-92 (КТ-26)
Типономинал
К1230ДП46П К1230ДП87П
К1230ДП461П К1230ДП871П

Корпус SOT-89 (КТ-47)
Типономинал
К1230ДП46Т К1230ДП87Т
К1230ДП461Т К1230ДП871Т

2 3 1

Корпус SO-8

Типономинал
К1230ДП46Т1 К1230ДП87Т1
К1230ДП46Т1 К1230ДП87Т1

ОСОБЕННОСТИ

- Компаратор с температурно-компенсированным порогом и гистерезисом, для предотвращения неустойчивости в пороговой зоне;
- Разброс напряжения срабатывания компаратора $\pm 2.5\%$ гарантируется в полном рабочем диапазоне температур;
- Встроенный гистерезис;
- Нагрузочная способность выхода Reset на втекающий ток не менее 10 мА;
- Гарантия правильной работы сигнала Reset при входном напряжении начиная с 1 В;
- Внутренний защитный диод для разряда конденсатора задержки (К1230ДП46х, К1230ДП87х);
- Низкий ток потребления в режиме ожидания.

ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ

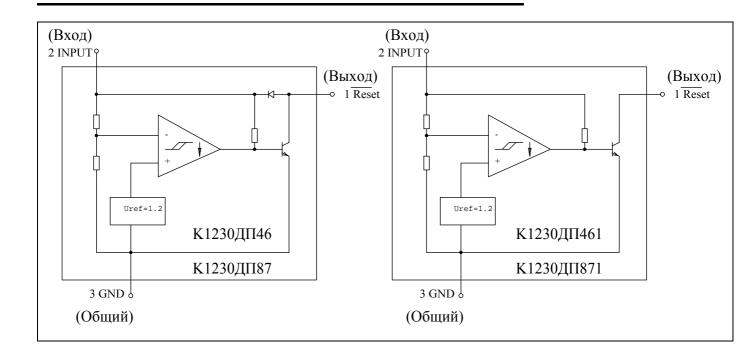
ТО-92 и SOT-89:

1	выход (Reset)
2	вход (Input)
3	общий (GND)

SO-8:

1	Выход (Reset)
2	вход (Input)
3, 5-8	свободный
4	общий (GND)

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Предельно-допустимые и предельные значения параметров, режимы

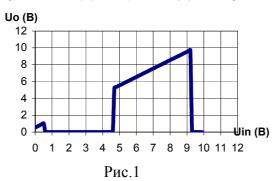
Наименование па	раметра,	Буквен		Но	рма	
единица измерения		ное.	Предельно-		Предельный	
		обозна-	допусти	мый ре-	реж	ким
		чение	жи	M		
			Не менее	Не более	Не менее	Не более
1 Напряжение питания, В	К1230ДП46хх	Uin	1	6.5	-1	10
	К1230ДП87хх			10.5		15
2 Выходное напряжение,В	К1230ДП46х	Uo	-	6.5	-	10
	К1230ДП87х			10.5		15
	К1230ДП461х, К1230ДП871х			20	-	22
3 Прямой ток через защитный	диод, мА	If				
(выв.1-2) К1230ДП46х, К1230	ДП87х		-	10	-	100
4 Максимально рассеиваемая	мощность, мВт	Pt		625		
5 Температура перехода, °С		Tj		125		150

Электрические параметры при T=+25°C (Если не указано иначе)

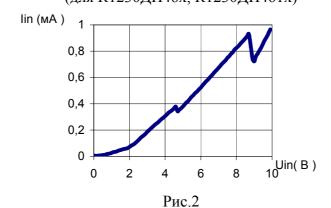
Наименование п	параметра,	Буквенное	Hoj	рма	Режим измерения
единица измерения		обозначе-	не	не	U, B
		ние	менее	более	
1 Напряжение срабатыва-	К1230ДП46х	Uth	4.45	4.65	T=25°C
ния, В	К1230ДП461х		4.4	4.7	от –45 до +85°С
	К1230ДП87х		8.5	8.9	T=25°C
	К1230ДП871х		8.45	8.95	от –45 до +85°С
2 Напряжение гистерезиса,	К1230ДП46х	Uh	0.01	0.05	
В	К1230ДП461х				
	К1230ДП87х		0.02	0.1	
	К1230ДП871х				
3 Остаточное напряжение,	К1230ДП46х	Uol	-	1.0	Uin=4 B, Is=8 MA
В	К1230ДП461х			0.4	Uin=4 B, Is=2 MA
				0.1	Uin=1 B, Is=0.2 мА
	К1230ДП87х				Uin=8 B, Is=8 MA
	К1230ДП871х				Uin=8 В, Is=2 мА
					Uin=1 B, Is=0.2 мА
4 Прямое падение напряжен диоде для К1230ДП46х, К12		Uf	0.6	1.2	If=10 _M A
5 Втекающий ток по выхо-	К1230ДП46х	Is	10	60	Uin, UReset=4B
ду, мА	К1230ДП461х				
	К1230ДП87х				Uin, UReset=8B
	К1230ДП871х				
6 Ток утечки на выходе,	К1230ДП46х	Iloh	-	0.5	Uin, UReset =5B
мкА	К1230ДП461х			1.0	Uin=5 B, UReset =20B
	К1230ДП87х		-	1.0	Uin, UReset =9B
	К1230ДП871х	\neg			Uin=9B, UReset =20B
7 Ток потребления в со-	К1230ДП46х	Iin	-	500	Uin=5 B
стоянии покоя, мкА	К1230ДП461х				
	К1230ДП87х			700	Uin=9B
	К1230ДП871х				

ТИПОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ

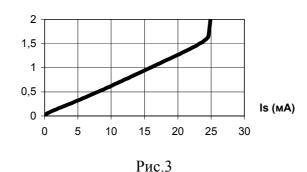
Зависимость выхода Reset от входного напряжения (Rl=10 кОм, Ta=25 °C) (для К1230ДП46х, К1230ДП461х)



Зависимость входного тока от входного напряжения (Rl=10 кОм, Ta=25 °C) (для $K1230Д\Pi46x$, $K1230Д\Pi461x$)

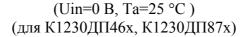


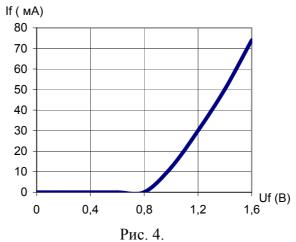
Зависимость остаточного напряжения на выходе Reset от втекающего тока (Uin=4.0 B, Ta=25 °C) (для К1230ДП46х, К1230ДП461х) (Uin=8.0 B, Ta=25 °C) (для К1230ДП87х, К1230ДП871х) Uol (B)



АО "ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ"

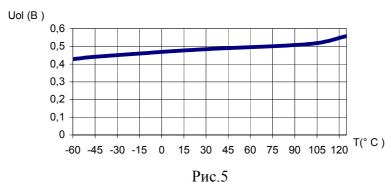
Зависимость прямого падения напряжения на защитном диоде от тока



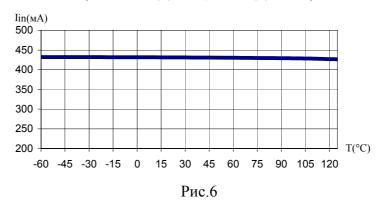


Зависимость остаточного напряжения от температуры (Uin=4B, Is=8мA) (для К1230ДП46х, К1230ДП461х)

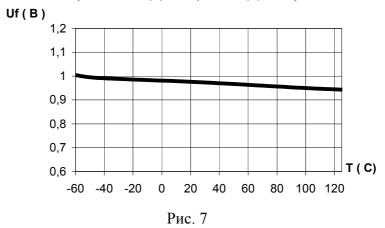
(Uin=8.0 B, Is=8мА Та=25 °C) (для К1230ДП87х, К1230ДП871х)



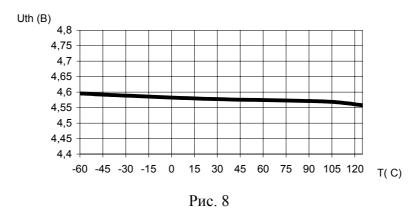
Зависимость тока потребления от температуры (Uin=5B) (для К1230ДП46х, К1230ДП461х)



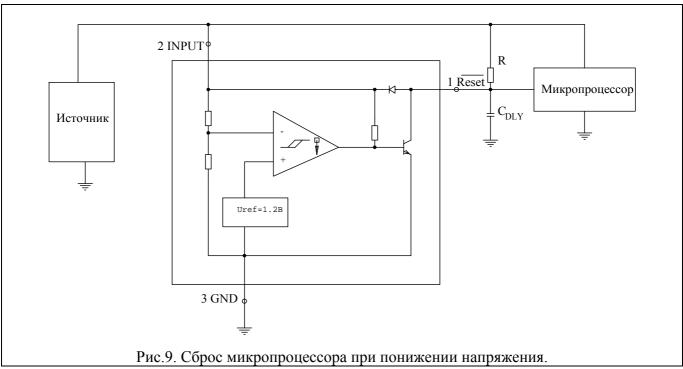
Зависимость прямого падения напряжения на защитном диоде от температуры (If=10мA) (для К1230ДП46х, К1230ДП87х)



Зависимость напряжения срабатывания от температуры (для К1230ДП46х, К1230ДП461х)

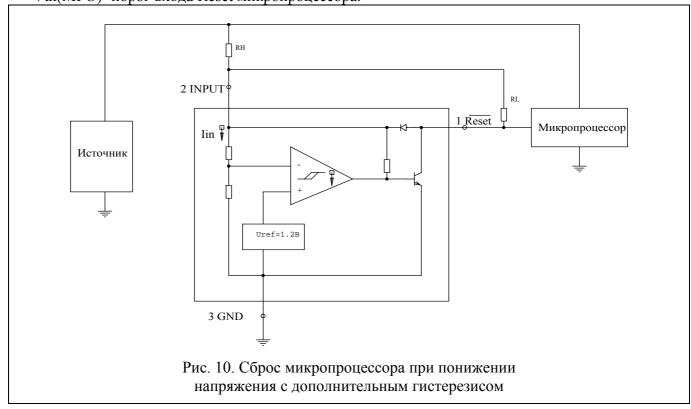


СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Сигнал Reset может быть задержан с помощью дополнительной емкости C_{DLY} . Для систем с очень быстрым нарастанием напряжения (<500 нс) рекомендуется, чтобы постоянная времени RC_{DLY} была больше 5 мкс.

- $t_{DLY}=RC_{DLY}ln(1/1-Uth(MPU)/Uin)$
- Vth(MPU)- порог входа Reset микропроцессора.

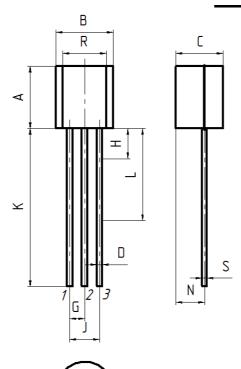


Гистерезис компаратора может быть увеличен с помощью резистора R_H . Формула для расчета гистерезиса упрощена и не принимает во внимание изменение входного тока в момент, когда напряжение Ucc пересекает уровень компарирования (рис.2). Увеличение нижнего порога $\Delta Uth(lower)$ будет наблюдаться благодаря Iin, типовое значение которого 340 мкА при 4.59 В . Формула дает результат с точностью $\pm 10\%$ для резистора R_H меньше, чем 150 Ом, R_L выбран от 1.5 до 10 кОм

- $U_H = 4.6R_H/R_L + 0.02$
- $\Delta \text{Uth(lower)} = 340 R_{\text{H}} \times 10^{-6}$
- $R_H \le 150 \text{ Om}$
- $R_L \ge 1.5 O_M, \le 10 \kappa O_M$

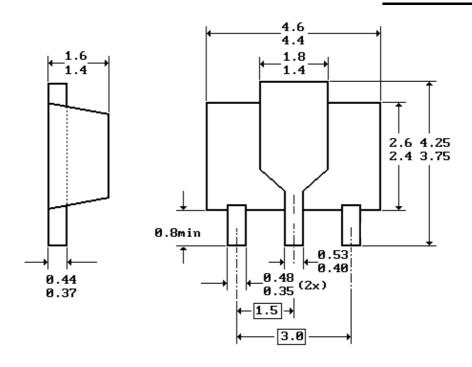
U _H	ΔUth	R_{H}	$R_{ m L}$
(мВ)	(мВ)	(Ом)	(кОм)
20	0	0	0
51	3.4	10	1.5
40	6.8	20	4.7
81	6.8	20	1.5
71	10	30	2.7
112	10	30	1.5
100	16	47	2.7
164	16	47	1.5
190	34	100	2.7
327	34	100	1.5
276	51	150	2.7
480	51	150	1.5

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА ТО-92

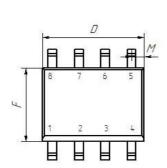


миллиметры				
	MUH	Μακτ		
А	4.32	5.33		
В	4.45	<i>5.20</i>		
Ĺ	<i>3.18</i>	4.19		
D	0.37	0.55		
G	<i>1.15</i>	1.39		
Н	-	2.54		
J	2.42	2.66		
K	12.70	-		
L	-	ı		
N	2.04	2.66		
R	3.43	-		
S	0.39	0.50		

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА SOT-89 (РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ММ)



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА SO-8



	миллиметрь	/	
	MUH	MOKE	
Α	135	175	
В	1.25	1.55	
C	0.36	0.48	
D	4.80	5.00	
Н	5.80	6.20	
Ε	5.80	6.20	
F	3.8	4.0	
G	0.65	0.85	
J	0.19	0.25	
K	0.25	0.50	
L	0.28	0.48	
M	0.60	0.60	
N	45°		
P	1.27	127	
R	3.81	3.81	
5	O°	8°	
U	0.10	0.25	

